

**تحديد طول الانتشار في نصف الناقل
كتابم لدرجة الحرارة بمساعدة التيار المحرض بحزمة إلكترونية**

الدكتور رامت إبراهيم*

(قبل للنشر في 19/6/1995)

□ ملخص □

نعرض هنا طريقة لتحديد طول انتشار حوامل شحنة الأقلية كتابم لدرجة الحرارة وذلك على أساس التأثير المتبادل ما بين الحزمة الإلكترونية ونصف الناقل. يحسب طول الانتشار من علاقة التيار المحرض بحزمة إلكترونية الذي يمثل كتابم أسي للبعد عن الوصلة P-n ويقارن مع نموذج نظري لحساب هذا التيار.

* مدرس في قسم الفيزياء - كلية العلوم - جامعة تشرين - اللاذقية - سورية.

Determination of Diffusion Length in Semiconductor as a Function of Temperature by Means of Electron Beam Induced Current

Dr. Ramez IBRAHIM*

(Accepted 19/6/1995)

□ ABSTRACT □

A method for determination the diffusion length of minority carrier as a function of temperature is presented. This is based on interaction between the electron beam and semiconductor. The diffusion length is calculated from the electron beam induced current. It is represented as an exponential function of distance the p-n junction and is compared with a theoretical model.

* Lecturer, Physics Department, Faculty of Science, Tishreen University, Lattakia, Syria.

1- مقدمة:

عندما يقذف نصف الناقل بحزمة إلكترونية تتولد في منطقة القذف أزواج إلكترون-ثقب (Electron-hole pair)، حيث تبلغ طاقة إنتاج زوج إلكترون-ثقب 3.6 eV في السيليسيوم [1].

ترداد بذلك الناقلية الكهربائية في موضع سقوط الحزمة الإلكترونية غير أنه بسبب إعادة الاتحاد السريعة (Recombination) لحوامل الشحنة الفائضة وبسبب قلة تركيز حوامل الشحنة المتولدة مقارنة بتركيزها في حالة التوازن يكون التغيير في الناقلية الكهربائية لنصف الناقل غير ملحوظ.

يصبح التغيير في الناقلية الكهربائية واضحاً إذا احتوى نصف الناقل على حاجز كموني مثل وصلة p-n (p-n junction) [2] أو حاجز شوتكي (Schottky-barrier) [3] أو حد حبيبي (Grain boundary) [4,5].

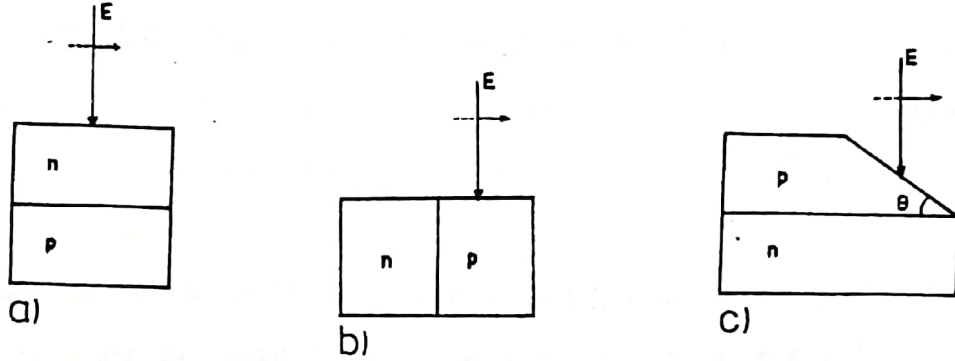
فعندما تتولد الأزواج (الإلكترون-ثقب) داخل منطقة الشحنة (Space charge) تنفصل هذه الأزواج بفعل حقل حاجز الكمون، أما عندما تتولد الأزواج خارج منطقة الشحنة ولكن بالقرب منها فإن حوامل شحنة الأقلية التي طول انتشارها Diffusion length كافٍ يمكنها الوصول إلى حاجز الكون عبر عملية الانتشار ثم تسرع حوامل الشحنة هذه في حقل حاجز الكمون ويعرف طول الانتشار بأنه المسافة الوسطية التي يقطعها حامل الشحنة عبر الانتشار خلال فترة حياته (عمره) (Life time).

وعند ربط نصف الناقل الحاوي على حاجز كمون بدارة قياس مناسبة تعمل حوامل الشحنة على إمرار تيار كهربائي في الدارة الخارجية. يدعى هذا التيار بالتيار المحرض بحزمة إلكترونية (Electron beam induced current EBIC) أو تيار الحواجز كونه ناتج عن التحريض بالإلكترونات، ولكي تكون قيمة هذا التيار كبيرة يجب أن تكون مقاومة دارة القياس صغيرة أو حتى معدومة.

إن دراسة هذا التيار تقدم معلومات مختلفة عن أنصاف النواقل، فبالإضافة إلى تحديد طول الانتشار، يمكن استخدامه لدراسة التآلق المهبطي (Cathode luminescence) ودراسة تغيير ارتفاع حاجز الكمون بتطبيق جهد خارجي في أنصاف النواقل [4] ودراسة الخسارة الإلكترونية (Electronic damage) الناجمة عن الحفر الأيوني في أنصاف النواقل [6]، تجدر الملاحظة إلى أنه يمكن استخدام التحريض بواسطة حزمة ضوئية للحصول على تيار الحواجز [7].

2- طريقة القياس والوصف التجريبي:

طورت طرق مختلفة لقياس تيار الحواجز (EBIC) وذلك من أجل تحديد طول انتشار حوامل شحنة الأقلية في أنصاف النواقل، حيث يوضح الشكل (1) ثلاث نماذج هندسية مختلفة لقياس تيار الحواجز (التيار EBIC).



الحزمة الإلكترونية عمودية على حاجز الكمون

الحزمة الإلكترونية موازية لحاجز الكمون

القطع المائل للعينات

الشكل (1) بعض الطرق المستخدمة لقياس التيار EBIC.

تسقط الحزمة الإلكترونية في الشكل (1-a) عمودية على حاجز الكمون [8] ويتم قياس تيار الحواجز كتابع لطاقة الإلكترونات المسرعة الساقطة على نصف الناقل حيث يبلغ التيار قيمة عظمى كتابع للطاقة. ومن أجل تحديد طول الانتشار بهذه الطريقة لابد من الوصف الرياضي للتيار كتابع لطاقة تسريع الحزمة الإلكترونية باعتبار طول الانتشار متحولاً في هذا الوصف. إن تيار الحواجز في دائرة الشكل (1-c) يتعلق بزواوية الميل θ إضافة لكونه تابع لموضع سقوط الحزمة الإلكترونية بالنسبة للوصلة p-n ومن خلال هذه التابعية يمكن حساب طول الانتشار [9]، تتميز هذه الطريقة بصعوبة تحضير وتجهيز العينات للقياس. يوضح الشكل (1-b) أكثر الطرق استخداماً وسهولة حيث تسقط الحزمة الإلكترونية بشكل مواز لمستوى الوصلة p-n (الحاجز الكموني) [10].

يقاس تيار الحواجز في هذه الحالة كتابع للمسافة x_0 عن مستوى الوصلة p-n وذلك من أجل طاقة تسريع معينة للحزمة الإلكترونية. يتعلق تيار الحواجز في هذه الحالة بعاملين أساسيين هما إعادة اتحاد حوامل الشحنة عند سطح العينة وشكل تابع توليد أزواج إلكترون-ثقب وعندما يكون طول الانتشار كبيراً بالمقارنة مع أبعاد المنطقة التي يتم داخلها توليد

حوامل الشحنة فإنه يمكن اعتبار تابع التوليد كمنبع نقطي والحصول على طول الانتشار من التابع الأسّي الذي يصف التيار الناتج:

$$I_{BS} \sim \exp(-x_s / L) \quad (1)$$

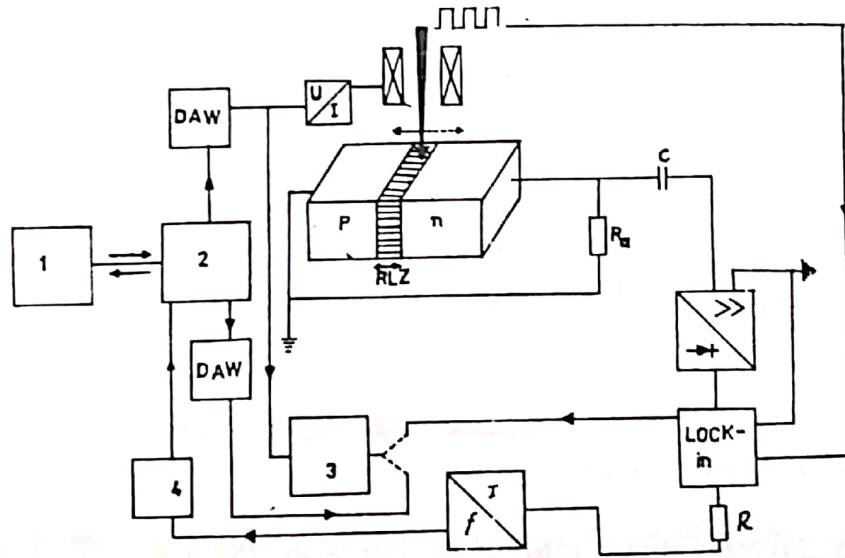
I_{BS} : التيار المحرض بحزمة إلكترونية أو تيار الحواجز.

x_s : البعد بين موقع سقوط الحزمة الإلكترونية ومستوى الوصلة p-n.

L : طول انتشار حوامل شحنة الأقلية.

تتميز طريقة الشكل (1-b) مقارنة بالطرق الأخرى بأن تحضير العينات وتجهيزها للقياس قليل التكلفة، كما أنه يمكن إجراء القياس في المنطقة ذات الناقلية n والمنطقة ذات الناقلية p على السواء، كذلك يمكن استخدام العينات لقياسات أخرى.

أجريت قياسات تيار الحواجز بواسطة مجهر إلكتروني نموذج SEM X Q ويوضح الشكل (2) آلية القياس بواسطة المجهر.



1- لوحة طباعة، 2- حاسب، 3- راسم، 4- عداد، DAW- محول الأرقام إلى إشارة.

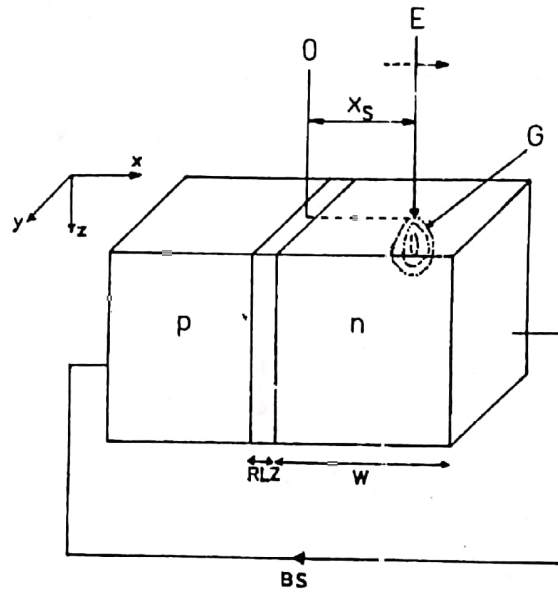
الشكل (2) مخطط دائرة قياس التيار بواسطة المجهر الإلكتروني.

تنتج الإلكترونات عبر تسخين سلك معدني (مهبط) إلى درجة عالية من الحرارة ثم تجمع بواسطة المصعد مشكلة الحزمة الإلكترونية، وتسرع الحزمة الإلكترونية المنطلقة من ثقب صغير في المصعد بتطبيق جهد كهربائي حيث تتراوح طاقة التسريع للحزمة الإلكترونية (5-50) KeV، كما ويتم انحراف الحزمة الإلكترونية في الاتجاه المرغوب عن مسارها

بواسطة حقل كهربائي. هذا وتفرغ حجرة المجهر بواسطة مضخة زيتية وذلك لتجنب امتصاص الإلكترونات وتبعثرها على جزيئات الهواء داخل الحجرة حيث يبلغ الضغط داخلها حوالي 0.1 mpa ميلي باسكال، كما ويعمل حاسب صغير على توجيه وتسجيل الإشارة المراد قياسها بعد تضخيمها وفصلها عن الإشارات غير المرغوبة.

3- الوصف الرياضي لتابعة تيار الحواجز للموضع:

نناقش تابعة تيار الحواجز للموضع عندما تقاد الحزمة الإلكترونية بشكل عمودي على المستوى العمودي على مستوى الاتصال p-n الشكل (3).



الشكل (3) طريقة القياس المستخدمة.

إذا فرضنا أن التابع $\Phi(x,y,z)$ يصف معدل التوليد (Generation rate) للأزواج إلكترون-ثقب في واحدة الحجم فإن تركيز حوامل الشحنة الفائضة يحقق خارج منطقة الشحنة معادلة الاستمرار التالية [11]:

$$D \operatorname{div} \operatorname{grad} n(x, y, z) - \frac{1}{\tau} n(x, y, z) + \Phi(x, y, z) = 0 \quad (2)$$

τ : عمر حوامل الشحنة.

D : ثابتة انتشار حوامل شحنة الأقلية.

حيث انه في حالة كون تركيز حوامل الشحنة الفائضة أقل من التركيز في حالة التوازن يمكن اعتبار كل من D و τ ثابتين.

يرتبط طول الانتشار بعمر حوامل الشحنة بالعلاقة التالية:

$$L^2 = D \cdot \tau \quad (3)$$

تأخذ بذلك العلاقة (2) الصيغة التالية:

$$\text{div grad } n(x, y, z) - \frac{1}{L^2} n(x, y, z) + \frac{1}{D} \Phi(x, y, z) = 0 \quad (4)$$

تحقق هذه العلاقة الشروط الحدية التالية:

يتم فصل جميع حوامل الشحنة عند حافة منطقة الشحنة ($x = 0$) بواسطة الحقل

الكهربائي لحاجز الكمون وهذا يعني انه يمكن إهمال إعادة الاتحاد عند تلك الحافة أي:

$$n(x = 0, y, z) = 0 \quad (5)$$

ويعبر عن إعادة الاتحاد على سطح نصف الناقل ($z = 0$) وعند حافته ($x = w$) بما يسمى

سرعة إعادة الاتحاد السطحية v (Surface recombination velocity)

$$D \frac{\partial n(x, y, z)}{\partial z} \Big|_{z=0} = v n(x, y, z = 0) \quad (6)$$

$$n(x = w, y, z) = 0 \quad (7)$$

باعتبار امتداد العينة كبير ($w \gg L$).

تساهم حوامل الشحنة التي تصل إلى حافة منطقة الشحنة في تيار الحواجز ويعبر عن

ذلك بالعلاقة:

$$I_{BS} = e \cdot D \int_{-\infty}^{\infty} dy \int_0^{\infty} dz \frac{\partial n(x, y, z)}{\partial x} \Big|_{x=0} \quad (8)$$

وبمراعاة الشرط الحدي (5) نحصل على قيمة التيار عند النقطة $x = 0$:

$$I_{BS}^0 = e \int_0^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} dy \int_0^{\infty} dz \Phi(x, y, z) \quad (9)$$

طورت نماذج مختلفة لوصف توليد حوامل الشحنة وحساب نتائج التكاملات (8) و(9)

نذكر منها اعتبار تابع التوليد منبع نقطي [11] وتابع أحادي الأبعاد وثلاثي الأبعاد [12] والحلول

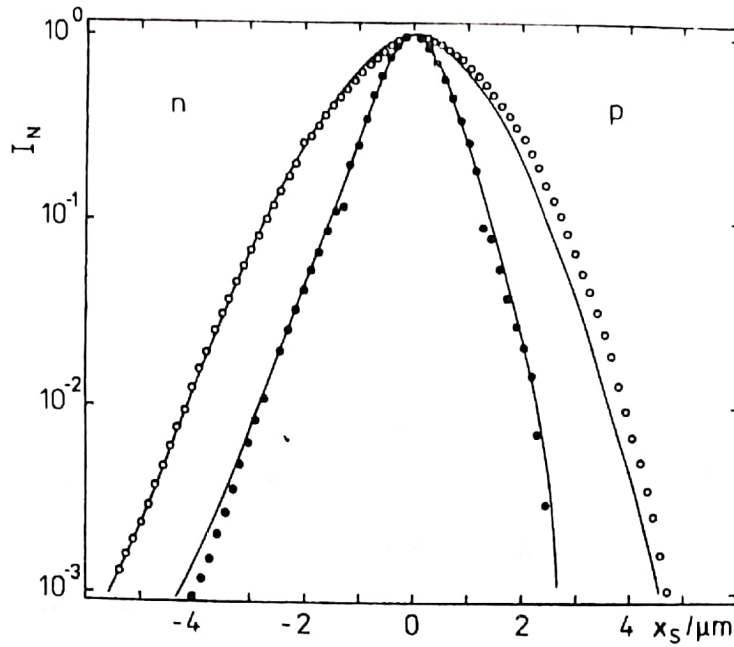
كانت جميعها موافقة للعلاقة (1).

4- النتائج والمناقشة:

4-1: تحديد طول الانتشار:

يوضح الشكل (4) نموذجاً لتابعة تيار الحواجز المنظم $I_N = I_{BS} / I_{BS}^0$ للموضع x_g

من القياسات على ديود من Ga As P في درجة حرارة قدرها 295 k.



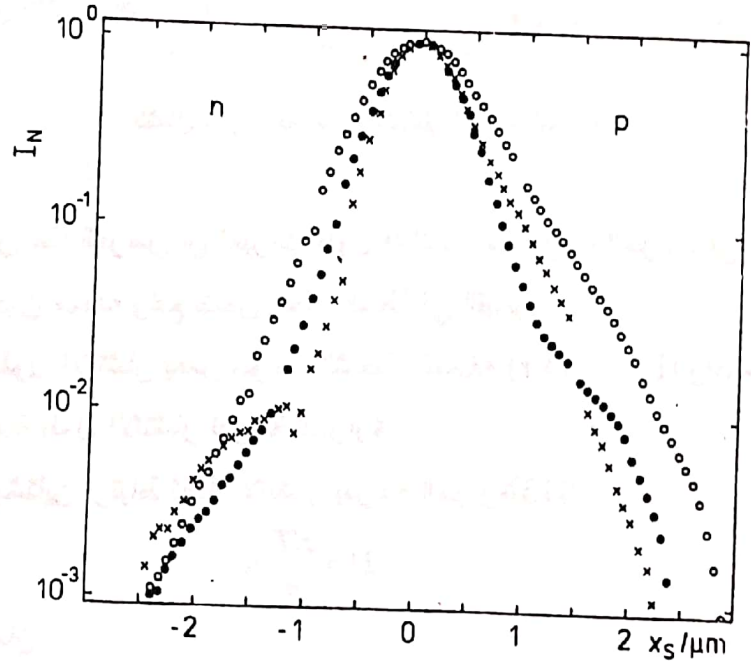
الشكل (4) تيار الحواجز المنظم I_N كتابع للموضع عند درجة الحرارة 295 k. طاقة التسريع 10 KeV لـ... و 20 KeV لـ... المنحنيات النظرية.

بالرغم من أن القياسات أجريت باستخدام قيمتين مختلفتين لطاقة تسريع الإلكترونات E_0 فإن المنحنيين متوازيان في الجزء الأكبر منهما وهذا يعني أن تيار الحواجز ناتج عن انتشار حوامل شحنة الأقلية إلى الوصلة p-n وان سرعة إعادة الاتحاد على سطح العينة في كلا الحالتين ثابتة.

تظهر المنحنيات بالقرب من الوصلة p-n تحديداً واضحاً ويفسر هذا التحديب عبر انجراف (Drift) حوامل شحنة الأقلية عوضاً عن الانتشار في المجال البعيد نسبياً عن الوصلة p-n واحتمال ان تكون سرعة إعادة الاتحاد السطحية معدومة في هذا المجال. كما يلاحظ من منحنيات الشكل (4) انه مع نقصان طاقة تسريع الحزمة الإلكترونية يزداد عدد حوامل الشحنة التي تصل إلى السطح حيث تتلاشى هناك عبر إعادة الاتحاد على السطح وهذا يؤدي بدوره إلى نقصان قيمة التيار. نفس ذلك بانه مع نقصان طاقة تسريع الإلكترونات تقترب منطقة توليد حوامل الشحنة من السطح وبالتالي يزداد احتمال وصولها إلى السطح فيزداد بذلك عدد حوامل الشحنة التي تصل إلى السطح وينقص عددها المساهم في التيار وهذا يتفق مع ما تظهره التجربة.

تمثل النقاط في الشكل القيم التجريبية الناتجة عن قياس تيار الحواجز كتابع للموضع أما المنحنيات فتعبر عن القيم النظرية المحسوبة وفق النموذج المعروض في الفقرة السابقة.

باستعمال القسم الخطي من منحنيات الشكل وحساب ميل هذا القسم ($I \sim \exp(-x/L)$) نحصل على L^{-1} وبالتالي على قيمة طول انتشار حوامل شحنة الأقلية. إن القيم الناتجة من المنحنيات التجريبية تتوافق مع القيم النظرية وبذلك يمكن القول بأن القيم الناتجة من ميل القسم الخطي للمنحنيات التجريبية تعبر بشكل جيد عن القيمة الحقيقية لطول الانتشار وذلك سواء في المنطقة ذات الناقلية n (تكون فيها الثقوب حوامل شحنة الأقلية) أو المنطقة ذات الناقلية p (تكون فيها الإلكترونات حوامل شحنة الأقلية) كذلك يوضح الشكل (5) نماذج مختلفة لتابعة تيار الحواجز للموضع وذلك في درجات حرارة مختلفة ($95, 130, 290$ k). يتبين من منحنيات الشكل (5) أنه يمكن الحصول على طول انتشار ثان في المجال $x > 1.1 \mu\text{m}$ ، حيث يظهر مجال خطي آخر للمنحنيات.

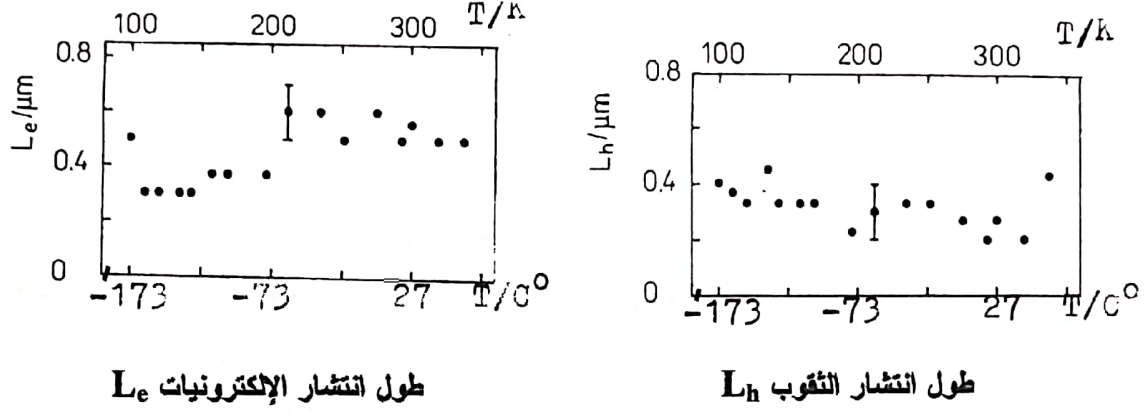


الشكل (5) تيار الحواجز المنظم كتابع للموضع في درجات الحرارة 95 k $\circ\circ$ و 213 k $\bullet\bullet$ و 290 k $\times\times$ طاقة التسريع $E_0 = 10$ KeV.

في هذه الحالة يمكن أيضاً الحصول على طول الانتشار في كلا المجالين لكلا المنطقتين ذات الناقلية n و p من ميل القسم الخطي للمنحنيات، حيث تم حساب قيم طول الانتشار في المجال الأول فقط $x < 1.1 / \mu\text{m}$.

2-4: تابعة طول الانتشار لدرجة الحرارة:

يوضح الشكل (6) تغيرات قيم طول الانتشار للإلكترونات L_e في المنطقة ذات الناقلية p وللثقوب L_h في المنطقة ذات الناقلية n كتابع لدرجة الحرارة.



الشكل (6) تابعة طول الانتشار لدرجة الحرارة.

يتبين من هذا العرض أن تغيرات طول الانتشار مع درجة الحرارة في المجال (95-300 k) تكاد تكون مهملة وتقع ضمن مجال الخطأ في القياس. يرتبط طول الانتشار بعمر حوامل الشحنة بالعلاقة $(L^2 = D \cdot \tau)$ واعتماداً على ذلك يمكن تفسير تابعة طول الانتشار لدرجة الحرارة.

توضح علاقة أينشتاين ارتباط ثابتة الانتشار بدرجة الحرارة [13]:

$$D = \frac{KT}{e} \mu \quad (10)$$

K ثابتة بولتزمان.

μ حركية (Mobility) حوامل الشحنة.

بالاستفادة من العلاقتين (3) و(10) يمكن أن نكتب:

$$L^2 = \frac{KT}{e} \mu \cdot \tau \quad (11)$$

غير أن حركية حوامل الشحنة في أنصاف النواقل GaP و GaAsP تتناسب مع درجة الحرارة وفق $\mu \sim T^{-a}$ في المجال $100 \text{ K} \leq T \leq 400 \text{ K}$ ، حيث $2.4 \leq a \leq 14$ [14] واعتماداً على ذلك تكتب العلاقة (11) بالصيغة:

$$L^2 \sim \tau \cdot T^{1-a} \quad (12)$$

هذا ويمكن تفريق عمر حوامل الشحنة إلى جزئين τ_r و τ_{nr} حيث تعبر τ_{nr} عن عمليات إعادة الاتحاد التي تتم دون إصدار إشعاعات و τ_r عن تلك التي تتم مع إصدار إشعاعات حيث ان $\tau^{-1} = \tau_{nr}^{-1} + \tau_r^{-1}$ يستدل من المراجع العلمية ان تغيرات τ_r مع درجة الحرارة مهملة مقارنة مع تغيرات τ_{nr} [15] وأن تتغير مع درجة الحرارة وفق $\tau_{nr} \sim (T^1 - T^{1.4})$ واعتماداً على هذا التحليل نجد من العلاقة (12) أن طول الانتشار لا يتغير مع درجة الحرارة في نصف الناقل GaAsP وهذا يتفق مع ما يوضحه الشكل (6).

5- النتيجة:

باستخدام طريقة التيار المحرض بحزمة إلكترونية (EBIC) لتحديد طول انتشار حوامل الشحنة في أنصاف النواقل استطعنا حساب طول انتشار الإلكترونات L_e والنقوب L_h وتأكدنا من أن طول الانتشار غير تابع لدرجة الحرارة في المجال (300 K - 95) من أجل نصف الناقل GaAsP.

ومن المهم مستقبلاً قياس تابعة طول الانتشار لدرجة الحرارة في أنصاف نواقل أخرى مشابهة لنصف الناقل المستخدم هنا.

REFERENCES

المراجع

- [1]- G. Oelgart, H. Scholz and Stegmann, *Experimentelle Technik der Physik* 28 (1980) 485-492.
- [2]- H. Haefner et al., *phys. Stat. Sol. (a)* 99 (1987) 657-667.
- [3]- D.E. Ioannou and C. A. Dimitianis, *IEEE Trans. Electron Dev. ED3* (1982) 445-450.
- [4]- R. Ibrahim, dissertation Humbolt Universitat Berlin 1990.
- [5]- A. Romanowski and D.B. Wittry, *J. Appl. Phys.* 60 (8) (1986) 2910-2913.
- [6]- G. Jäger-Waldau et al., *J. appl. Phys* 75 (2) (1994) 804-808.
- [7]- C. Hu and C. Drowley, *Solid-State Electronics* 21 (1978) 965-968.
- [8]- C.J. Wu and D.B. Wittry, *J. Appl. Phys.* 49 (5) (1978) 2827-2836.
- [9]- W.H. Hackett, *J. Appl. Phys.* 42 (1971) 3249-3251.
- [10]- H.J. Leamy *J. Appl. Phys.* 53 (6)(1982)R51-R80.
- [11]- D.B. Wittry and D.F. Kyser, *J. appl. Phys.* 38 (1967)375-382.
- [12]- G. Oelgart, 6. Tagung Mikrosonde Dresden 1984.
- [13]- V.L. Bonc-Bruevic and S.G. Kalasnikov, *Halbleiterphysik VEB Deutscher Verlag des Wissenschaften, Berlin* 1982.
- [14]- C. Hilsum and A.C. Ross-Innes, *Semiconducting III-V compounds Pergamon Press Oxford. London. New York. Paris* 1961.
- [15]- M. Kittler, W. Seifert and K.W. Schröder, *phys. Stat. Sol. (a)* 93 (1986) K101-K104.